

控

特許協力条約に基づく国際出願
国際予備審査請求書

第 II 章

出願人は、次の国際出願が特許協力条約に従って国際予備審査の対象とされることを請求する。

国際予備審査機関記入欄

国際予備審査機関の確認

請求書の受理の日

PCT
15.3.05
受領印

第 I 欄 国際出願の表示		出願人又は代理人の書類記号
国際出願番号 PCT/JP2004/015777	国際出願日 (日、月、年) 25. 10. 2004	TUO4-1005WO1 優先日 (最先のもの) (日、月、年) 19. 11. 2003

発明の名称

高純度ハフニウム、同高純度ハフニウムからなるターゲット及び薄膜並びに高純度ハフニウムの製造方法

第 II 欄 出願人

氏名 (名称) 及びあて名 : (姓、名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記載; あて名は郵便番号及び国名も記載)
株式会社 日鉱マテリアルズ
Nikko Materials Co., Ltd.
〒105-0001 日本国東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
10-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0001 JAPAN

電話番号 : 03-5573-6564
ファクシミリ番号 : 03-5573-6779
加入電信番号 :
出願人登録番号 :

国籍 (国名) : 日本国 JAPAN 住所 (国名) : 日本国 JAPAN

氏名 (名称) 及びあて名 : (姓、名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記載; あて名は郵便番号及び国名も記載)

新藤 裕一郎 SHINDO Yuichiro
〒319-1535 日本国茨城県北茨城市華川町臼場187番地4
株式会社日鉱マテリアルズ磯原工場内
c/o Isohara Factory of Nikko Materials Co., Ltd.
187-4, Usuba, Hanakawa-cho, Kitaibaraki-shi, Ibaraki 319-1535 Japan

国籍 (国名) : 日本国 JAPAN 住所 (国名) : 日本国 JAPAN

氏名 (名称) 及びあて名 : (姓、名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記載; あて名は郵便番号及び国名も記載)

国籍 (国名) : 住所 (国名) :

その他の出願人が続葉に記載されている。